

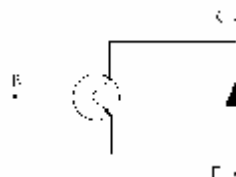
13007D

硅 NPN 高压开关晶体管芯片 (4")

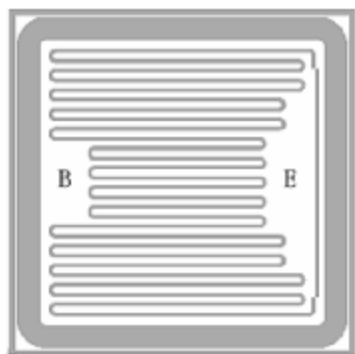
■ 用途

主要用于节能灯、日光灯电子镇流器及其它开关、振荡电路。

■ 内部结构



■ 芯片示意图



■ 芯片结构

芯片尺寸	3300×3300μm ²
压焊区尺寸	基区 450μm×790μm 发射区 470μm×990μm
芯片厚度	240±10μm
锯片槽宽度	90μm
金属层	正面: Al 4.0±0.5μm 背面: Ag 1.4±0.2μm

■ 电特性(T_a=25℃)

项 目	符 号	测 试 条 件	最小值	最大值	典型值	单 位
集电极-基极反向电流	I _{CB0}	V _{CB} =670V		1		μA
发射极-基极反向电流	I _{EB0}	V _{EB} =9V		1		μA
集电极-基极击穿电压	BV _{CB0}	I _C =0.1mA		700	760	V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C =1mA	400		450	V
发射极-基极击穿电压	BV _{EB0}	I _E =0.1mA	9			V
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} =5V, I _C =2A	15	40		
集电极-发射极饱和电压	V _{CE(sat)}	I _C =3A, I _B =0.7A		0.6		V
特征频率	f _T	V _{CE} =10V, I _C =0.5A	4			MHz
贮存时间	t _s	I _C =500mA	4	8		μs